IEC 62418

Edition 1.0 2010-04

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Semiconductor devices – Metallization stress void test

Dispositifs à semiconducteurs – Essai sur les cavités dues aux contraintes de la métallisation

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

Q

ICS 31.080

ISBN 978-2-88910-697-4

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

CONTENTS

FOREWORD 3
1 Scope 5
2 Test equipment 5
3 Test structure 5
3.1 Test structure patterns 5
3.2 Line pattern 5
3.3 Via chain pattern 5
3.3.1 Pattern types 5
3.3.2 Pattern for aluminium (Al) process 5
3.3.3 Pattern for copper (Cu) process 6
4 Stress temperature 6
5 Procedure 6
5.1 Stress void evaluation methods 6
5.2 Resistance measurement method 6
5.3 Inspection method 7
6 Failure criteria 8
6.1 Resistance method 8
6.2 Inspection method 8
7 Data interpretation and lifetime extrapolation (resistance change method) 8
8 Items to be specified and reported 9
8.1 Resistance change method 9
8.2 Inspection method 10
Annex A (informative) Stress migration mechanism 11
Annex B (informative) Technology-dependent factors for aluminium 13
Annex C (informative) Technology-dependent factors for copper 14
Annex D (informative) Precautions 15
Bibliography 17

Figure A.1 – Schematic representation of the stress-void formation mechanism in Al 11

Table 1 – Void classification 7

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES – METALLIZATION STRESS VOID TEST

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62418 has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47/2043/FDIS	47/2050/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

SEMICONDUCTOR DEVICES – METALLIZATION STRESS VOID TEST

1 Scope

This International Standard describes a method of metallization stress void test and associated criteria. It is applicable to aluminium (Al) or copper (Cu) metallization.

This standard is applicable for reliability investigation and qualification of semiconductor process.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 19
1 Domaine d'application 21
2 Équipement d'essai 21
3 Structure d'essai 21
3.1 Modèles de structure d'essai 21
3.2 Modèle de ligne 21
3.3 Chaîne de trous de liaison 21
3.3.1 Types de modèles 21
3.3.2 Modèle pour le traitement à l'aluminium (Al) 22
3.3.3 Modèle pour le traitement au cuivre (Cu) 22
4 Température de contrainte 22
5 Procédure 22
5.1 Méthodes d'évaluation des cavités dues aux contraintes 22
5.2 Méthode de mesure de résistance 22
5.3 Méthode d'inspection 23
6 Critères de défaillance 24
6.1 Méthode de la résistance 24
6.2 Méthode d'inspection 24
7 Interprétation des données et extrapolation sur la durée de vie (méthode de variation de résistance) 24
8 Éléments à spécifier et rapporter 26
8.1 Méthode de variation de résistance 26
8.2 Méthode d'inspection 26
Annexe A (informative) Mécanisme de migration de contrainte 28
Annexe B (informative) Facteurs dépendant de la technologie pour l'aluminium 30
Annexe C (informative) Facteurs dépendant de la technologie pour le cuivre 31
Annexe D (informative) Précautions 32
Bibliographie 34

Figure A.1 – Représentation schématique de l'apparition de cavités dues aux contraintes générées par le mécanisme de formation dans l'aluminium (AL) 28

Tableau 1 – Classification des cavités 24

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_____

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – ESSAI SUR LES CAVITÉS DUES AUX CONTRAINTES DE LA MÉTALLISATION

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62418 a été établie par le comité d'études 47: Dispositifs à semi-conducteurs

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47/2043/FDIS	47/2050/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous “http://webstore.iec.ch” dans les données relatives à la publication recherchée. . A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – ESSAI SUR LES CAVITÉS DUES AUX CONTRAINTES DE LA MÉTALLISATION

1 Domaine d’application

La présente Norme Internationale décrit une méthode d'essai sur les cavités dues aux contraintes générées par la métallisation et les critères associés. Elle s’applique à la métallisation à l’aluminium (Al) ou au cuivre (Cu).

La présente norme s'applique à l'étude de la fiabilité et à la qualification du processus à semiconducteurs.